

# Diodos aplicados à sensores digitais de imagem

Leandro Assis dos Santos

8 de março de 2022

## Introdução

Sensores digitais de imagem são sensores que transduzem a intensidade luminosa incidente sobre eles em sinais elétricos analisáveis por um sistema computacional. Esses sensores são usados em imagens eletrônicas aplicadas a diversos dispositivos como câmeras digitais, mouses ópticos, equipamentos de imagem médica, equipamentos de visão noturna e térmica, LIDARs (Light Detection and Ranging), dentre outros.

Os sensores de imagem são feitos de fótodiodos, que é um tipo de diodo construído de forma a possibilitar a utilização da incidência de luz como fator determinante no controle da corrente elétrica, e um ou mais transistores ativos. Ou seja, os fótons incidentes sobre o sensor interagem com o fótodiodo para mover elétrons de forma proporcional ao aumento da intensidade luminosa no cristal, juntamente a isso os transistores atuam de forma programada, como será visto mais a frente, a fim de registrar a imagem,. Os sensores modernos de imagem utilizam da exploração desse efeito fotoelétrico concomitantemente da característica capacitiva que junções pn em polarização reversa (fótodiodos em polarização reversa) possuem.

Em resumo, ao polarizar um diodo reversamente com uma fonte de tensão  $V_R$  (Figura 1: Diodo polarizado reversamente.), o campo elétrico interno da junção pn que constitui o diodo é reforçado. Por conta disso, a barreira de potencial se fortalece e mais íons (de ambos, aceitadores e doadores) ficam expostos. Devido ao campo induzido pelo terminal negativo da fonte  $V_r$ , as lacunas da região p são atraídas para o extremo do ânodo do diodo, e de forma similar (mas por conta do campo induzido pelo terminal positivo) os elétrons são atraídos para o extremo do cátodo do diodo.

Em razão da concentração de cargas nos extremos do diodo e do aumento da barreira de potencial, isto é, o aumento da voltagem entre as extremidades da



Figura 1: Diodo polarizado reversamente.

região de depleção, a região de depleção se torna mais larga e podemos pensar nos extremos do diodo como as placas de um capacitor. A junção pn portanto, quando polarizada reversamente, possui capacitância dependente de  $V_R$ .

Uma vez que possui-se o fótodiodo funcionando como um capacitor sob uma tensão reversa, o dispositivo se carregará com um dado valor  $V_C$  que depende do tempo ao qual o fótodiodo (agora agindo como capacitor) ficou alimentado pela tensão reversa. Com o fótodiodo carregado permite-se a entrada de luz sobre o sensor, que resultará em uma indução de corrente na junção pn e, conseqüentemente, em uma alteração na tensão  $V_C$ . A partir da observação individual da tensão  $V_C$  em uma matriz de fótodiodos é possível fazer a transdução da luz incidente sobre o sensor em uma imagem.

## Tipos de sensores de imagem

Os sensores de imagem podem ser separados em dois principais tipos, eles são os CCDs (*Charge-Couple Device*) e os sensores CMOS, configurações de sensores baseados em APS (*Active Pixel Sensor*), estes podendo ser classificados de acordo com o número de transistores por pixel, como por exemplo 3T-APS,

4T-APS e assim por diante. Ambos os dispositivos são feitos com tecnologia MOS (*Metal Oxide Semiconductor*), com CCDs baseados em capacitores MOS e os sensores CMOS baseados em amplificadores MOSFET. A seguir entra-se em mais detalhes sobre cada tipo de sensor, suas características, histórias, vantagens e desvantagens.

## A história dos sensores de imagem

Os sensores CCDs são pioneiros no ramo de imagem digital e sua origem remonta às pesquisas com tecnologia MOS de Willard Boyle e George E. Smith. Durante a pesquisa descobriram que uma carga elétrica poderia ser armazenada em pequenos capacitores MOS, descoberta essa que se tornou a base para o sensor CCD, inventado em 1969.

Apenas em 1980 surgiu um fator chave para os sensores CMOS modernos, o fótodiodo “fixado” (do inglês PPD - Pinned PhotoDiode) inventado por Nobukazu Teranishi, Hiromitsu Shiraki e Yasuo Ishihara. O diferencial desse componente em relação aos demais é o baixo *lag*, baixo ruído, alta eficiência quântica (taxa de conversão de fótons em elétrons) e baixa corrente quando aplicado a pouca luminosidade. A partir de 1987, os PPDs começaram a ser incorporados na maioria dos sensores CCDs, e desde então são usados em todos os sensores CCD e CMOS.

Apesar dos sensores CCDs terem sido pioneiros no ramo de medição científica nos anos 80 e se tornado o sensor de escolha para praticamente toda aplicação de imagens nesta época, o desenvolvimento de sensores CMOS atingiu um ponto em que começou a substituir os sensores CCDs em aplicações de baixa performance. Com o passar do tempo os sensores de tecnologia CMOS se expandiram, enquanto os de tecnologia CCD estagnaram. De forma geral, ambos os dispositivos são utilizados de acordo com a necessidade da aplicação.

## Sensores de Pixel Passivo - PPS

Os precursores dos sensores APS foram os PPS (do inglês, passive-pixel sensor), um tipo de matriz de pixels formada por fótodiodos e uma chave MOSFET, que consiste em “pixels passivos” lidos sem amplificação, ou seja, essa configuração de pixel transfere diretamente o sinal acumulado para fora do pixel. Nesses sensores cada pixel possui uma junção pn, capacitor integrado e transistores de sele-

ção. Essa configuração de pixels passivos foi proposta por G. Weckler em 1968 e antecedeu a criação dos CCDs. Os PPS sofrem de diversas limitações como alto ruído, baixo tempo de leitura e dificuldade de escalabilidade. De forma geral, os sensores CCDs são baseados em pixels passivos.

## Sensores de Pixel Ativos - APS

Esses sensores consistem de “pixels ativos”, que consiste em um ou mais amplificadores MOSFET que convertem a carga fóto gerada em uma tensão, amplifica o sinal de tensão e reduz o ruído. Esse conceito de pixel foi proposto por Peter Noble em 1968, entretanto esta topologia de pixels só foi fabricada a partir de 1985 devido as evoluções nos processos de fabricação dos transistores MOS. Os sensores CMOS utilizam dessa configuração de pixels para seu funcionamento, tendo como principal diferença o uso de transistores CMOS ao invés de transistores PMOS ou NMOS.

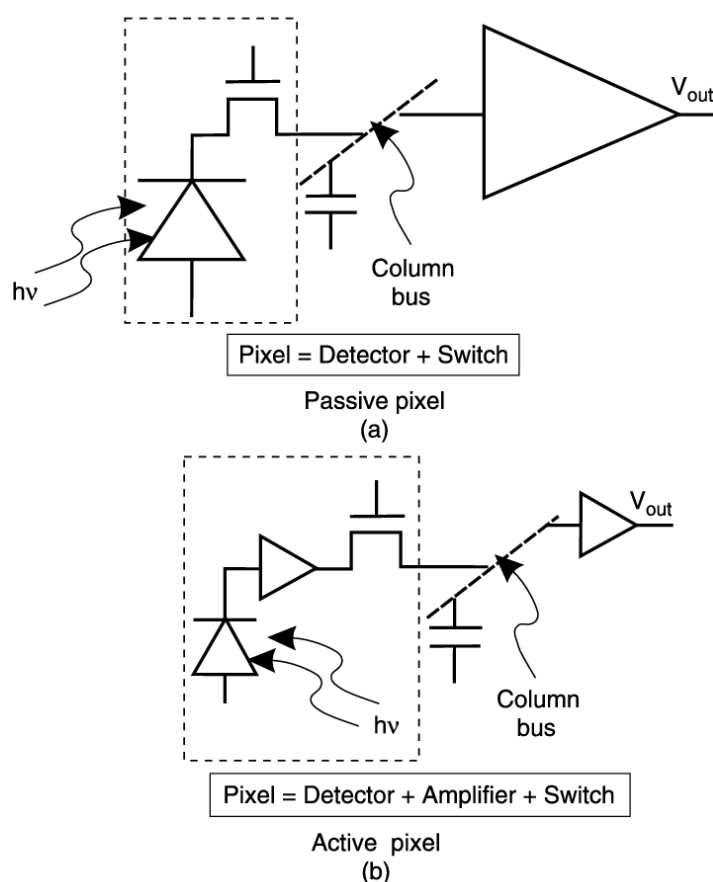


Figura 2: Apresentação das configurações de PPS (a) e APS (b).

## **Sensores CCD**

Fazer quarta

## **Sensores CMOS**

Fazer quarta

## **CCD vs. CMOS**

Fazer quarta

## **Simulação de um sensor CMOS simplificado**

Fazer quinta

## **Projeto de um sensor CMOS simplificado**

Fazer quinta

## **Extra: Separação de cores**

Fazer quarta